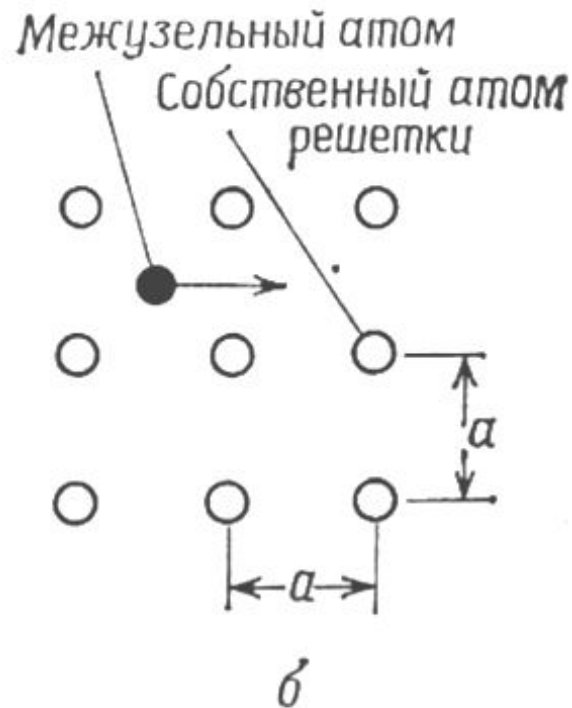
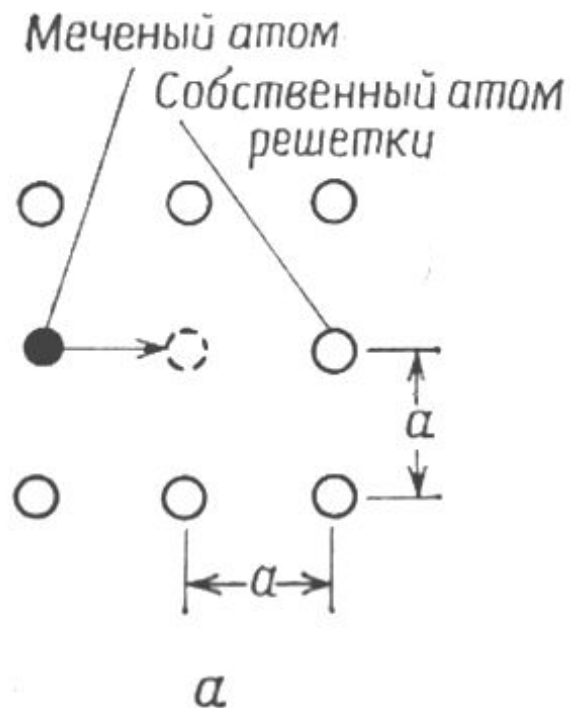


Диффузия



В твердом теле диффузия – процесс активируемого температурой перескока атома из одной потенциальной ямы в другую.

Законы Фика

- $j = -D \text{ grad } N,$

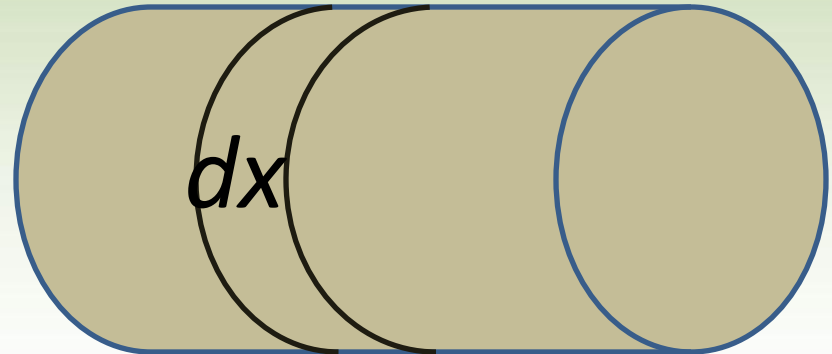
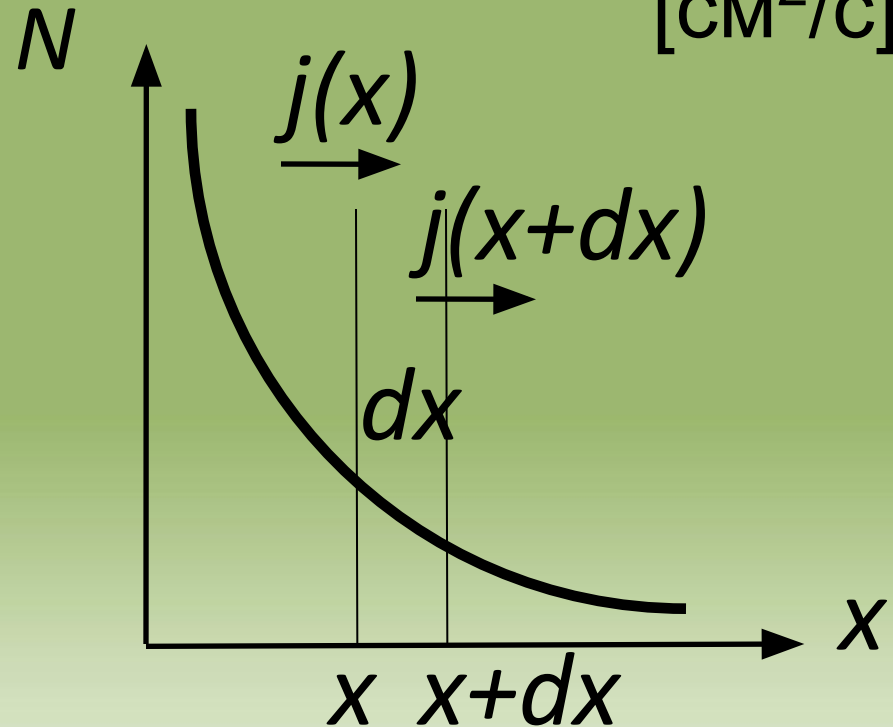
$$\frac{dj}{dx} = - \frac{d}{dx} \left[D \frac{dN}{dx} \right]$$

$$\frac{dj}{dx} = - \frac{dN}{dt}$$

- $\frac{\partial N}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} \left[D \frac{\partial N}{\partial x} \right]$

$$D(T) = D_0 \exp(-E/kT)$$

[cm²/c]



Диффузия из одной полуограниченной области в другую

$$N(x, t) = \frac{N_0}{2} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2 \cdot \sqrt{D \cdot t}}\right) = \frac{N_0}{2} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{L}\right)$$

Крайевые условия

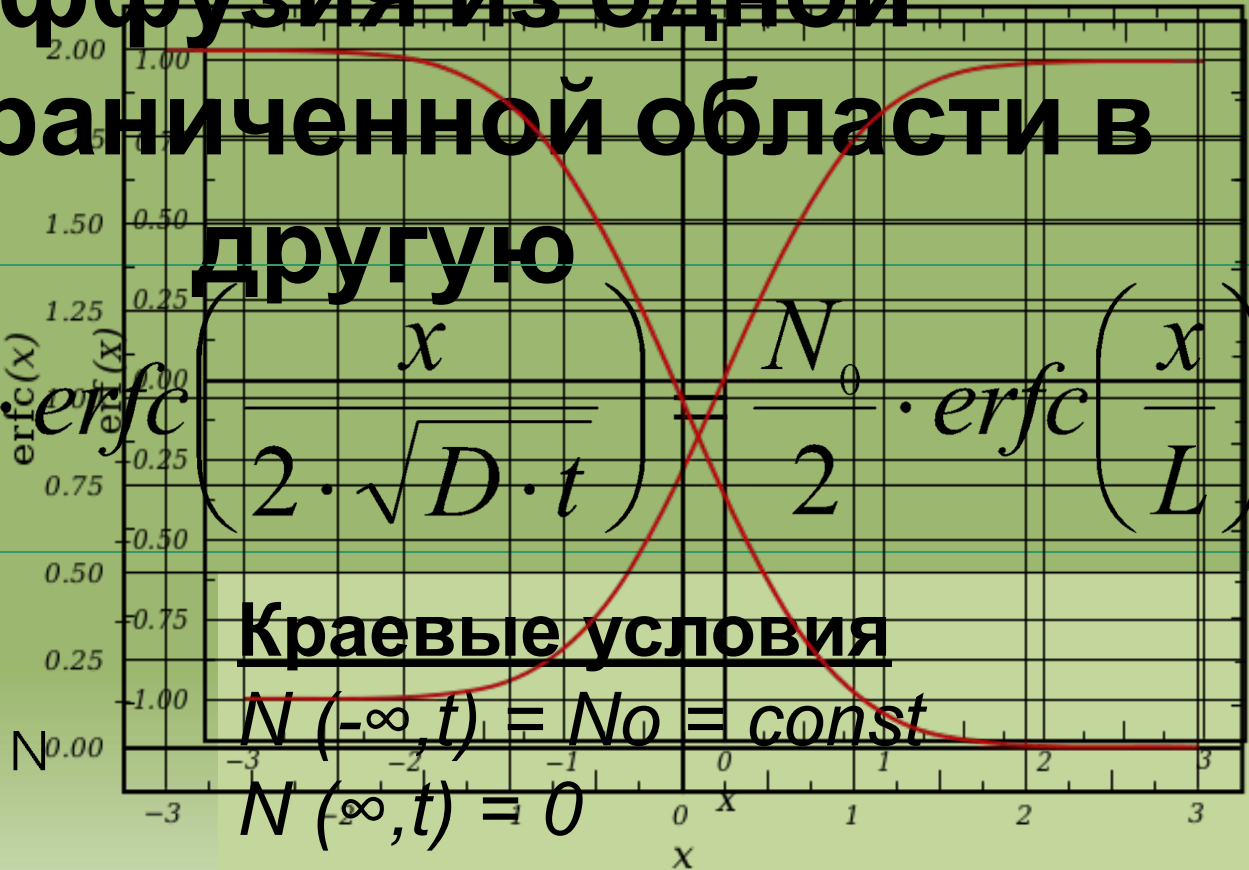
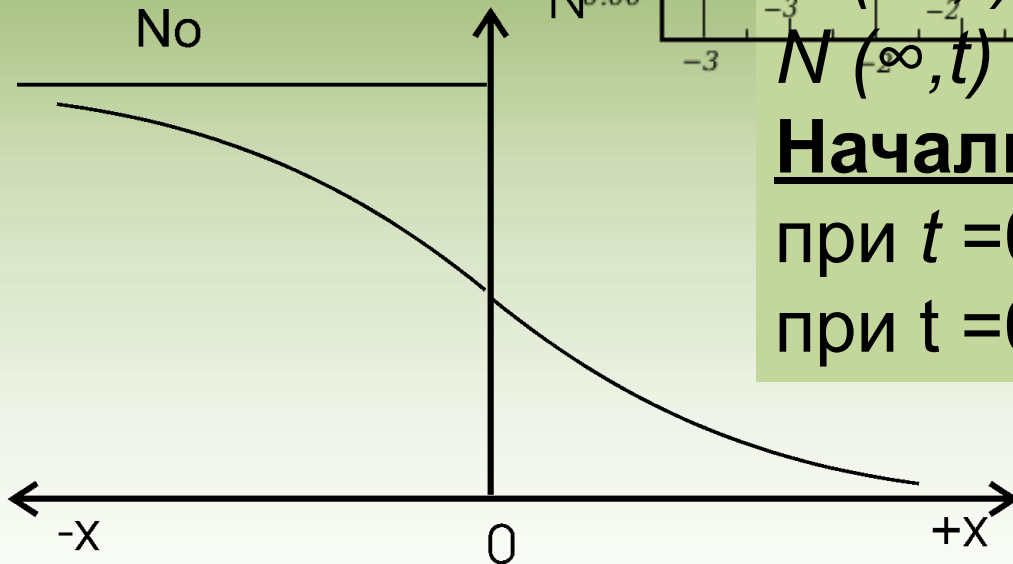
$$N(-\infty, t) = N_0 = \text{const}$$

$$N(\infty, t) = 0$$

Начальные условия

$$\text{при } t = 0 \text{ и } x \rightarrow +0, N(x, 0) \rightarrow 0$$

$$\text{при } t = 0 \text{ и } x \rightarrow -0, N(x, 0) \rightarrow N_0$$



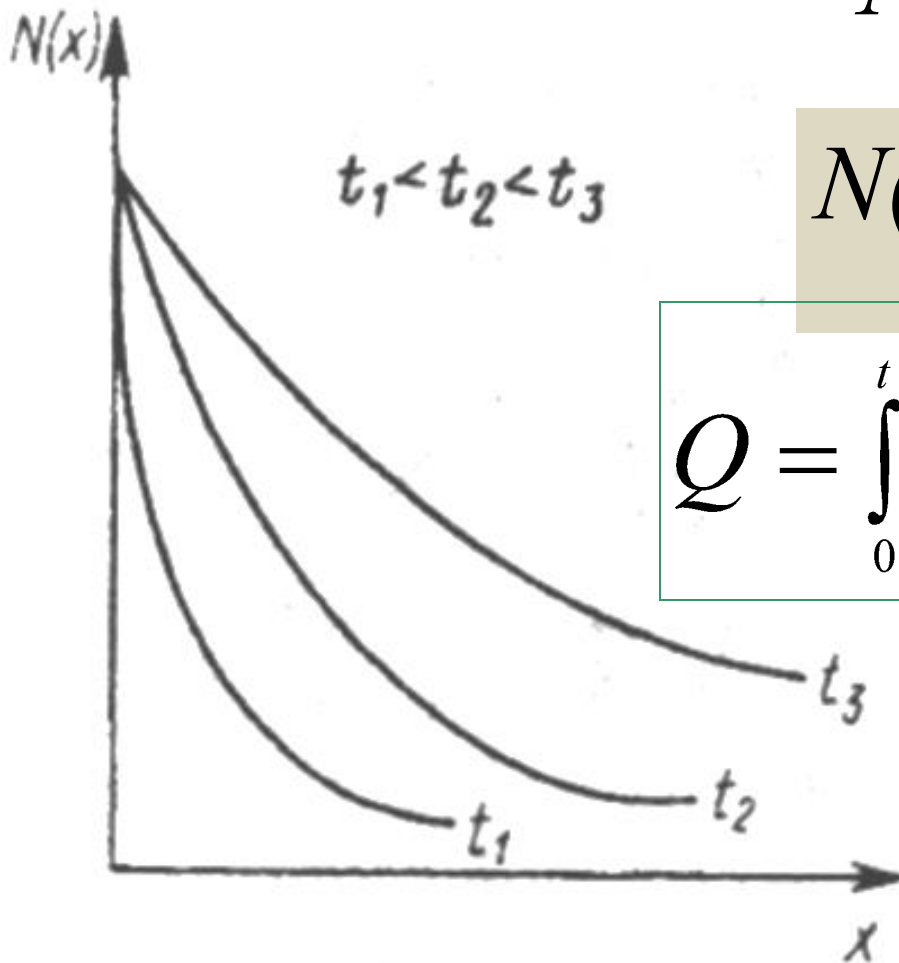
$$L = 2 \cdot \sqrt{D \cdot t}$$

Диффузия из неограниченного источника примеси

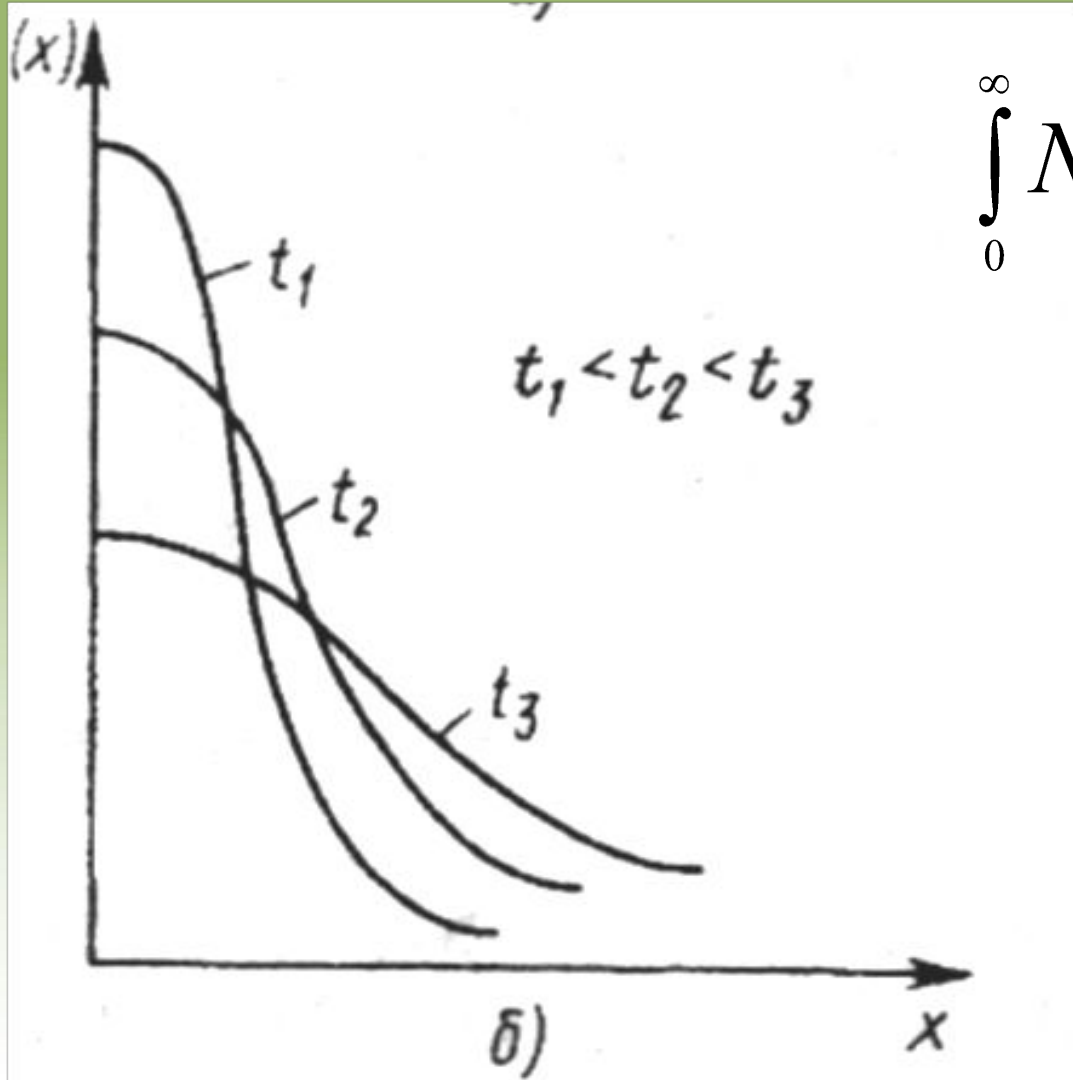
$$N(0, t) = N_s = \text{const}$$

$$N(x, t) = N_s \operatorname{erfc}(x/L)$$

$$Q = \int_0^t j(t) dt = 2N_s \cdot \frac{\sqrt{D \cdot t}}{\sqrt{\pi}}$$

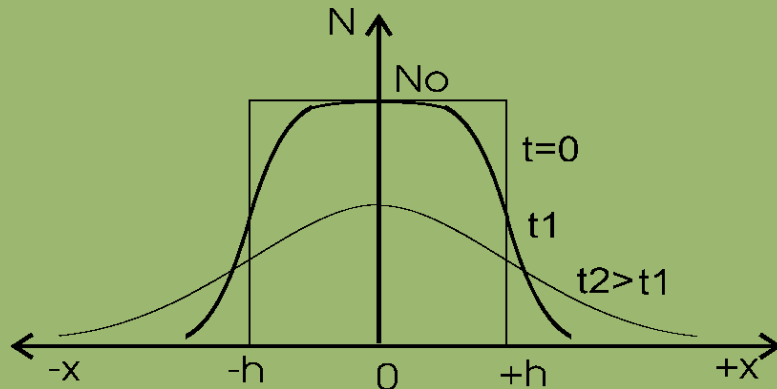


Диффузия из ограниченного источника примеси



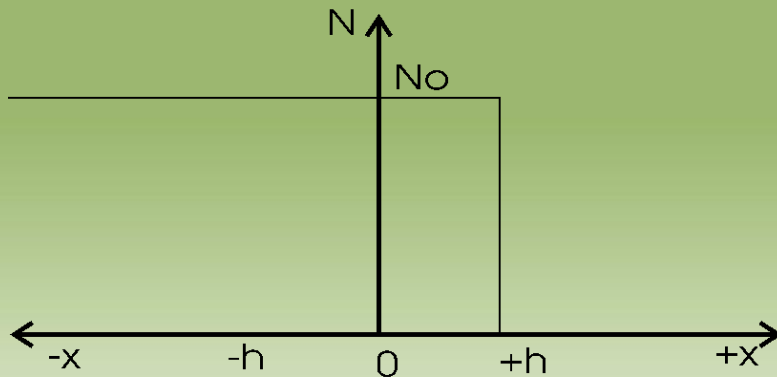
$$\int_0^{\infty} N(x) dx = Q = \text{const}$$

Диффузия из слоя конечной толщины

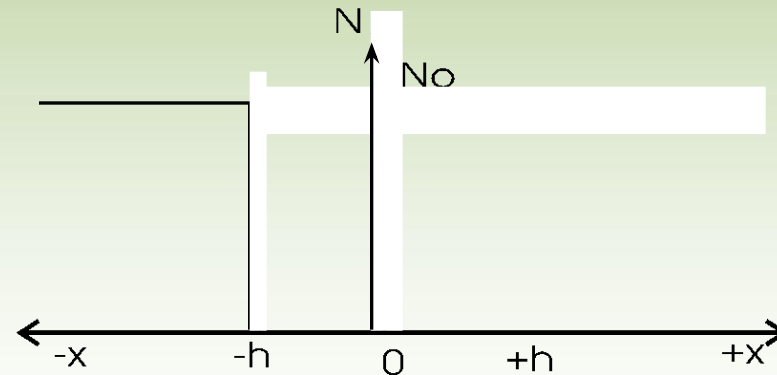


суперпозиция двух профилей $N_1 - N_2$

$$N(x, t) = \frac{N_0}{2} \cdot \left\{ \operatorname{erfc}\left(\frac{x-h}{L}\right) - \operatorname{erfc}\left(\frac{x+h}{L}\right) \right\}$$



$$N_1(x, t) = \frac{N_0}{2} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{x-h}{L}\right)$$



$$N_2(x, t) = \frac{N_0}{2} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{x+h}{L}\right)$$

Диффузия из бесконечно тонкого слоя (точечный источник)

$$N(x, t) = \frac{N_0}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left\{ \int_{(x-h)/L}^{\infty} \exp(-u^2) du - \int_{(x+h)/L}^{\infty} \exp(-u^2) du \right\} =$$
$$= \frac{N_0}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_{(x-h)/L}^{(x+h)/L} \exp(-u^2) du$$

При $h \rightarrow 0$ интеграл стремится к $\frac{2 \cdot h}{L} \cdot \exp(-x^2/L^2)$

$$2h \cdot N_0 = Q = \text{const}$$

$$L^2 = 4 \cdot D \cdot t$$

$$N(x, t) = \frac{N_0}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{2h}{L} \cdot \exp(-x^2/L^2) = \frac{Q}{2 \cdot \sqrt{\pi} \cdot D \cdot t} \cdot \exp(-x^2/(4D \cdot t))$$

Понятие тонкого и толстого слоя

$h > 4L$ – слой толстый

$h < L/4$ – слой тонкий

Отражающая и связывающая границы

Граница, поток примеси через которую равен 0 –
отражающая.

Граница, концентрация примеси на которой равна 0 –
связывающая (поглощающая).

$$N(x, t) = N_0 \cdot \left[1 - \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{L}\right) \right] = N_0 \cdot \operatorname{erf}\left(\frac{x}{L}\right)$$

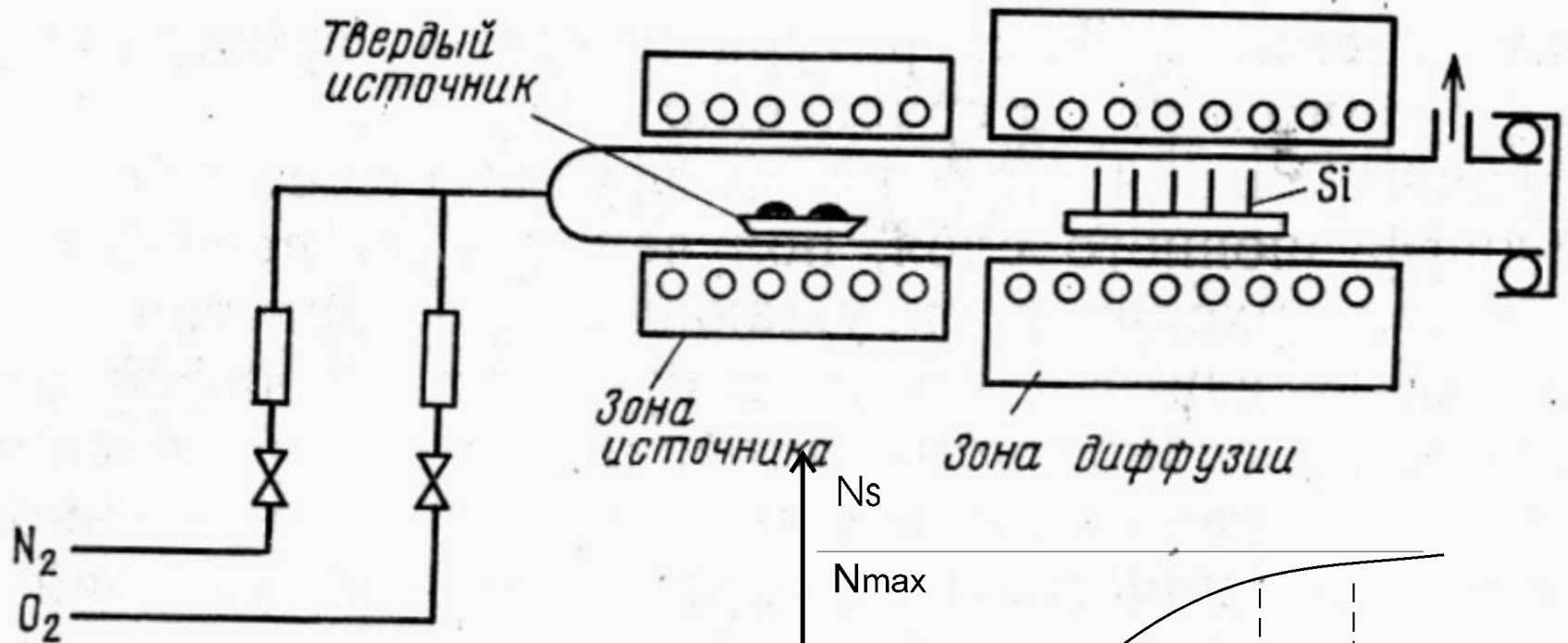
Факторы, влияющие на величину коэффициента диффузии

- **Температура** процесса.
 $D(T) = D_0 \exp(-E/kT)$
- Механические напряжения и сопутствующая им **повышенная концентрация дислокаций**. Вдоль дислокаций диффузия примеси идет во много раз быстрее, чем в бездефектном материале.
- Концентрация диффундирующей примеси.
- Концентрация фоновой примеси.
- Атмосфера, в которой ведется диффузия примеси.
- Ориентация кристалла.

диффузия из пленок, наносимых на поверхность полупроводника

- Пленки металлов, например, Au или Al, нанесенные методом термического испарения. Толщина пленок определяется требуемым количеством примеси, которое должно быть введено в полупроводник.
- Слои легированного оксида кремния или легированного поликремния.
- Пленки фоторезистов- диффузантов. В этих пленках обычными методами фотолитографии можно сформировать рисунок областей, подлежащих

Диффузия в потоке газ-носителя

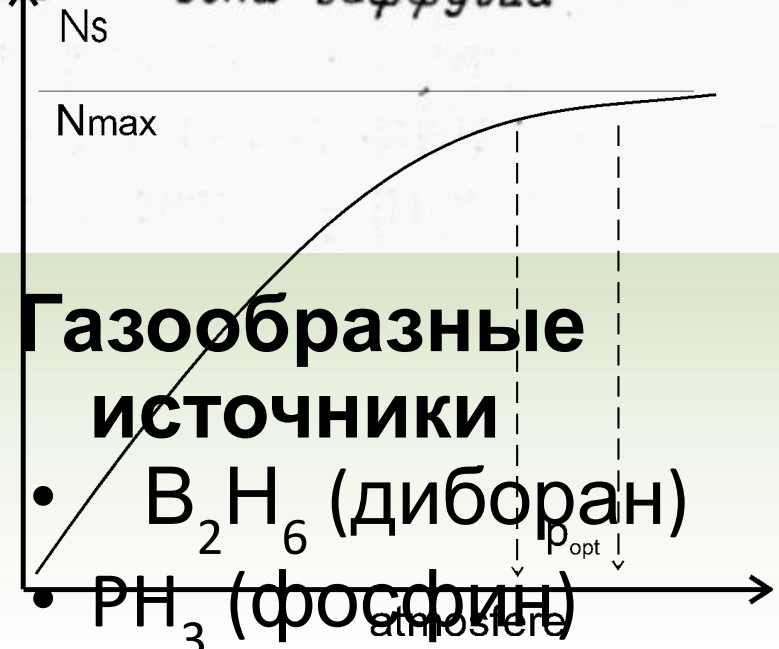


Твердые источники

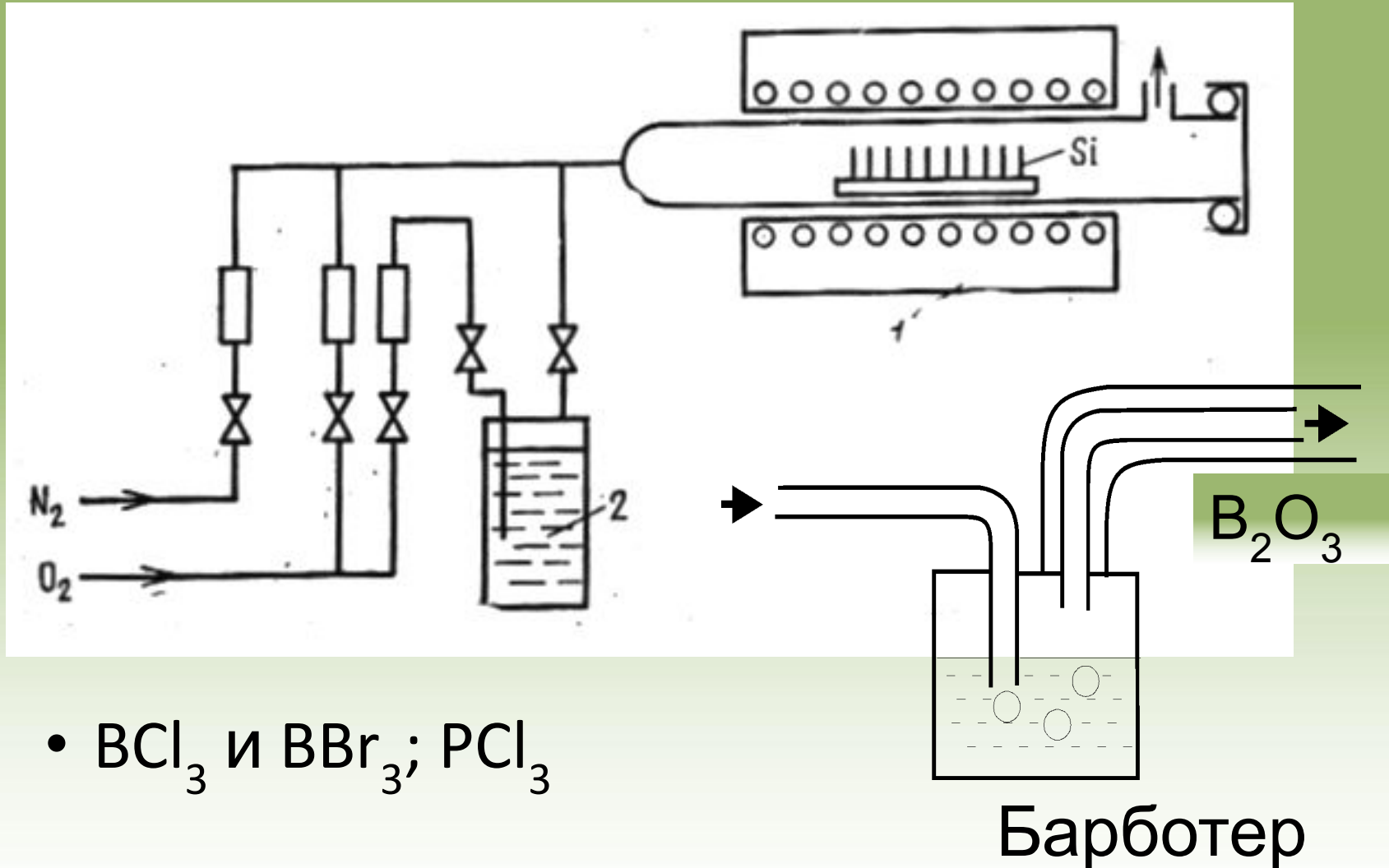
- БСС ($nB_2O_3 \cdot mSiO_2$), B_2O_3
- ФСС ($nP_2O_5 \cdot mSiO_2$)

Газообразные источники

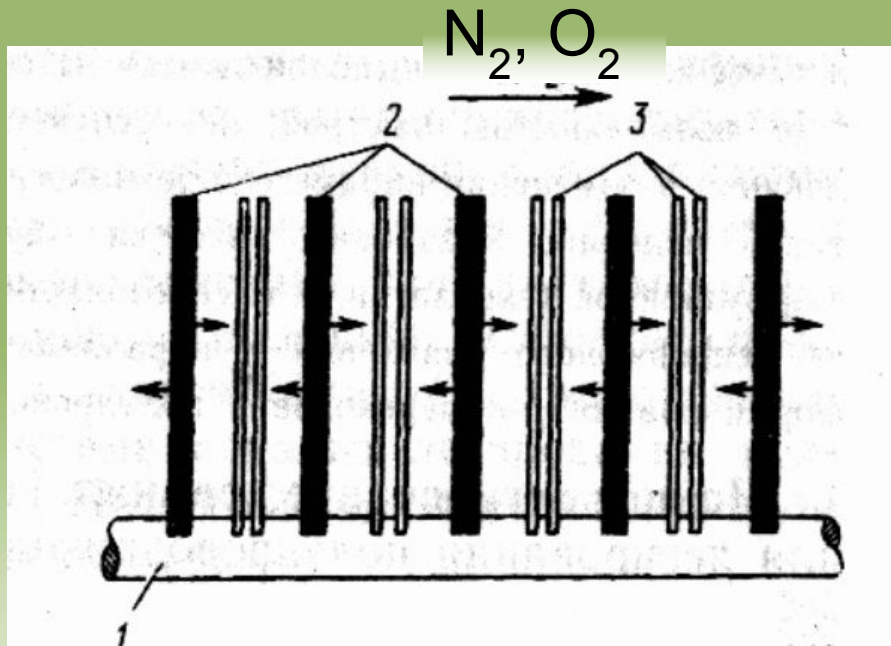
- B_2H_6 (диборан)
- PH_3 (фосфин)



Диффузия в потоке газа-носителя из жидкого источника



Метод параллельного источника



BN (нитрид
бора) B_2O_3

Установка твердых
планарных
источников и
пластин кремния –
в кварцевой
кассете:

- 1 – кварцевая кассета;
- 2 – твердые планарные источники;
- 3 – пластины

Двух- и трехмерные точечные источники

$$N(r, t) = \frac{Q}{(4\pi Dt)^m} \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{4Dt}\right) = \frac{Q}{(4\pi Dt)^m} \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{L^2}\right)$$

r - расстояние от источника диффузанта

$m = 1/2, 1$ и $3/2$, соответственно, для одно-, двух- и трехмерного источников

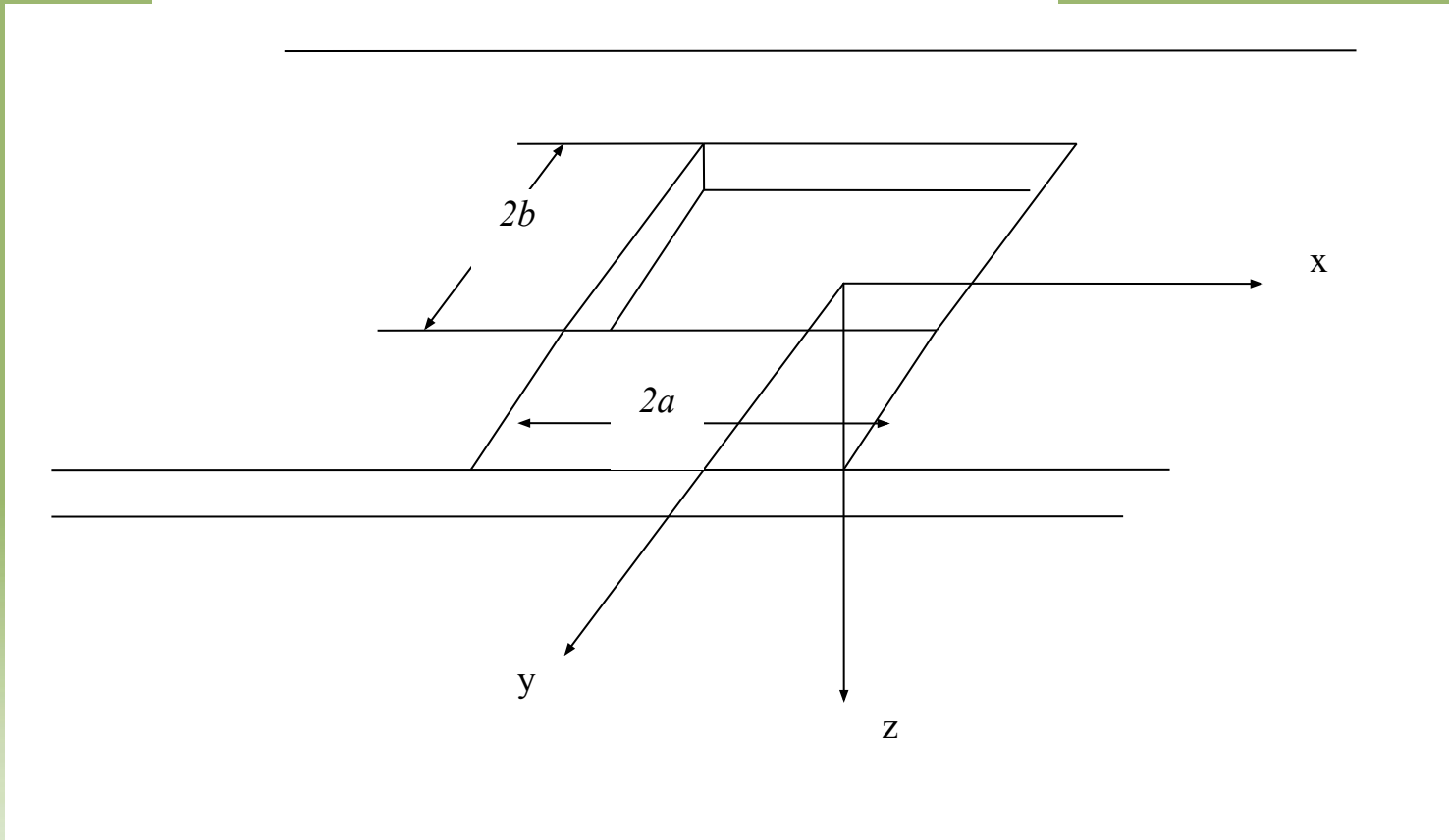
Формула Пуассона

$$N(x, y, z, t) = \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{F(\chi, \eta, \zeta)}{(4\pi Dt)^{3/2}} \exp\left[-\frac{(x-\chi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}{4 \cdot D \cdot t}\right] d\chi d\eta d\zeta$$

$$N(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(\chi)}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left[-\frac{(x-\chi)^2}{4 \cdot D \cdot t}\right] d\chi$$

$$F(N(x, y, z, t)) = F(N(x, t)) \cdot F(N(y, t)) \cdot F(N(z, t))$$

Диффузия в прямоугольное окно



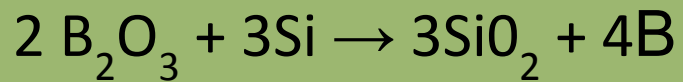
$$N(x, y, z, t) = \frac{N_S}{4} \cdot \left[\operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{L}\right) - \operatorname{erfc}\left(\frac{x+a}{L}\right) \right] \cdot \left[\operatorname{erfc}\left(\frac{y-b}{L}\right) - \operatorname{erfc}\left(\frac{y+b}{L}\right) \right] \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{L}\right)$$

Источники диффузанта

- **Бор (В)**

B_2H_6 (диборан); смесь (порядка 5%) с Ar

БСС ($nB_2O_3 \cdot mSiO_2$), B_2O_3



ТПИ – BN (нитрид бора)

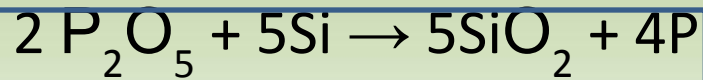
BCl_3 и BBr_3

- **Фосфор (Р), мышьяк (As) и сурьма (Sb)**

PCl_3 , оксихлорид фосфора $POCl_3$

PH_3 (фосфин); $2 PH_3 \rightarrow 3H_2 + 2P$

P_2O_5 , ФСС ($nP_2O_5 \cdot mSiO_2$)

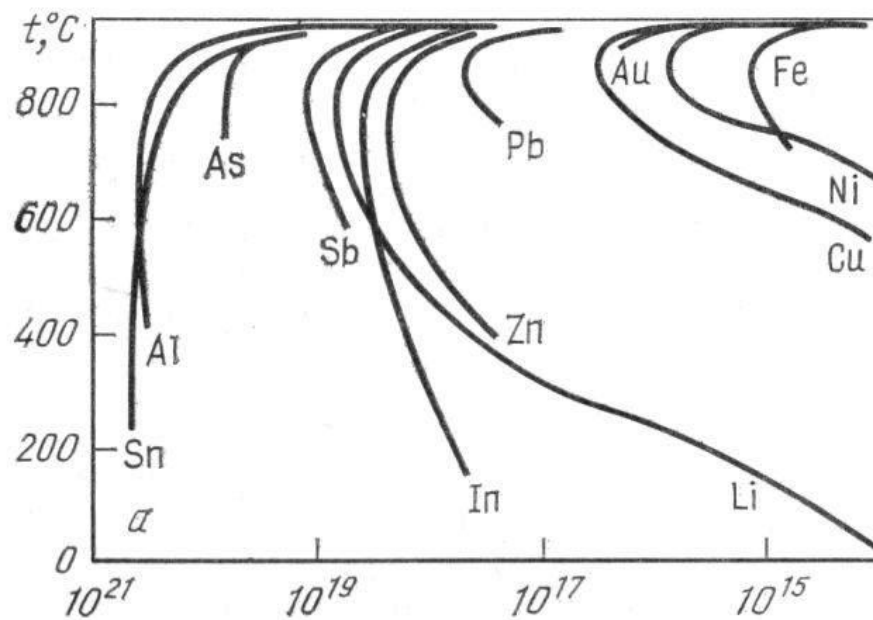


Поверхностные источники: ортофосфаты кремния, $(NH_4)_2HPO_4$,
ФСС

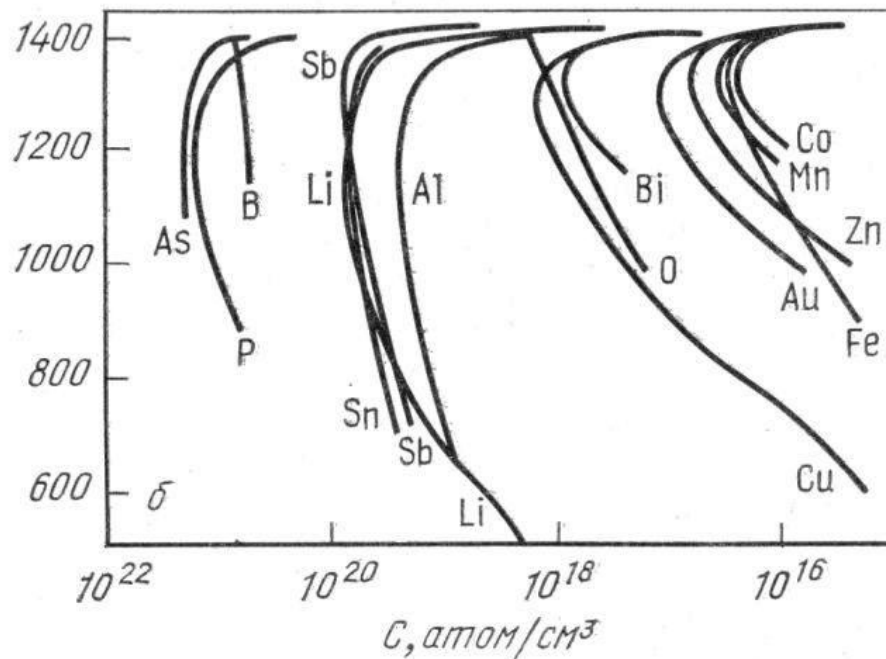
ТПИ: нитрид фосфора, фосфид кремния, ФСС, метафосфат алюминия, пирофосфат кремния

Выбор легирующей примеси

- **Система энергетических уровней, создаваемых данной группой примесей в запрещенной зоне полупроводника.**
Все основные донорные и акцепторные примеси в кремнии (элементы V и III групп) имеют $E_a \approx 0.06$ эВ. Исключением является In: $E_a \approx 0.16$ эВ от E_v (используется при создании фотоприемных устройств).
Примеси, имеющие энергетические уровни, расположенные вблизи середины ЗЗ, например, Au, применяются для снижения времени жизни ННЗ.
- **Предельная растворимость примеси.**
Р ($1,5 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$), As ($2 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$), Sb ($5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$).
В ($5 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$), Al ($2 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$).
- **Величина коэффициента диффузии.**
Наибольший коэффициент диффузии D имеет Al. Заметно уступают ему В и Р. Очень велики D у Au и O_2 .
- **Технологичность.** В первую очередь D в Si и SiO_2 .



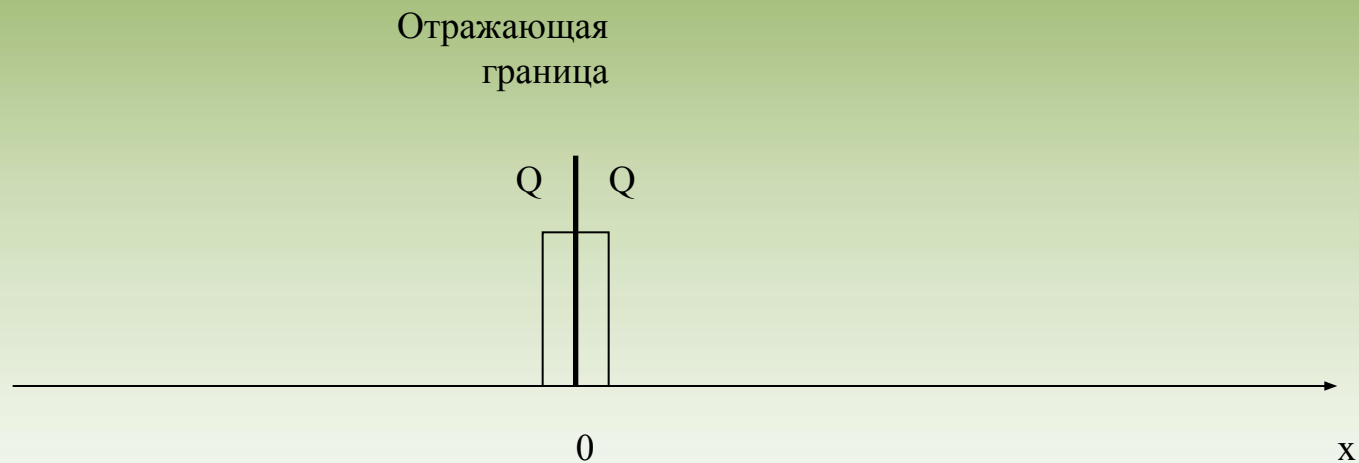
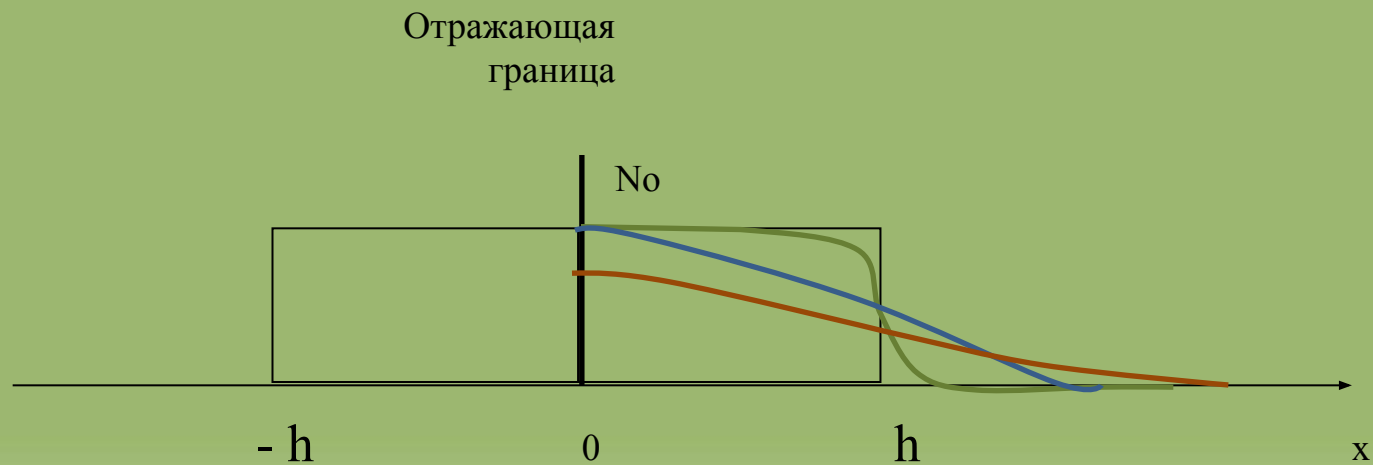
Ge



Si

Ретроградная растворимость примесей в германии (а) и кремнии (б)

Отражающая граница



Связывающая (поглощающая) граница

